



ОКП 63 41

Транзистор 2T505

ЭТИКЕТКА

ЮФ3.365.084 ЭТ

Кремниевые планарные р-п-р транзисторы типов 2T505А, 2T505Б в металлокерамическом корпусе КТ-2-7 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы во вторичных источниках питания и переключающих устройствах.

Транзисторы чувствительны к воздействию статического электричества.

Код даты изготовления транзисторов по ГОСТ 30668-2000.
Заключение Ус-во по стандартизации и сертификации
документы на транзисторы России № ВС-01-454
01.08.04

Схема расположения выводов



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при $T_{окр} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока, ($U_{KB} = 10 \text{ В}$, $I_E = 0,5 \text{ А}$)	h_{213}	25		
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{KB} = 300 \text{ В}$)	I_{KB0}		100	
2T505A.			100	
($U_{KB} = 250 \text{ В}$)				
2T505B				
Обратный ток эмиттера, ($U_{EB} = 5 \text{ В}$), мкА	I_{EB0}	100		
Границное напряжение, ($I_K = 0,02 \text{ А}$, $\Delta t_{изм} \geq 250 \text{ мкс}$, $Q \geq 50$, $t_u = 300 \text{ мкс} \pm 10\%$, $U_{огр} = 320 \text{ В} \pm 10\%$), В	$U_{K30 \text{ гр}}$	250	200	
2T505A				
2T505B				
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, ($I_K = 0,5 \text{ А}$, $I_B = 0,1 \text{ А}$), В	$U_{K3 \text{ нас}}$	1,8		
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_K = 0,5 \text{ А}$, $I_B = 0,1 \text{ А}$), В	$U_{B3 \text{ нас}}$	1,8		

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.

транзисторов:
золото 1,502 г

1.3 Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка транзисторов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 25000 ч, а в облегченных режимах и условиях при мощности 0,5 , токах и напряжениях не более 0,7 максимально допустимых значений - 50000 ч при температуре окружающей среды 25 °C.

2.2 Гамма-процентный ресурс транзисторов $T_y = 95\%$ в режимах и условиях допускаемых ТУ 50000 ч, а в облегченном режиме - 100000 ч.

2.3 Минимальный срок сохраняемости транзисторов при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или во всех местах хранения транзисторов, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, 25 лет.

При хранении транзисторов в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом, а также на открытой площадке минимальные сроки сохраняемости соответствуют ГОСТ В 28146-89.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям аА0.339.174 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и технических условиях на транзисторы.

Гарантийный срок - 25 лет с даты изготовления, а в случае перепроверки транзисторов - с даты перепроверки.

Гарантийная наработка:

25000 ч - в режимах и условиях, допускаемых ТУ,
50000 ч - в облегченном режимеГарантийная наработка исчисляется в пределах
гарантийного срока.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2T505А, 2T505Б соответствуют техническим условиям аА0.339.174 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 6 от 29.01.04
дата

Место для штампа СКК

Место для штампа ПЗ 12Место для штампа "Перепроверка произведена" 3.02.05
датаПриняты по извещению № 66 от 3.02.05
дата

Место для штампа СКК

Место для штампа ПЗ 6

Цена договорная